

SOT223 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

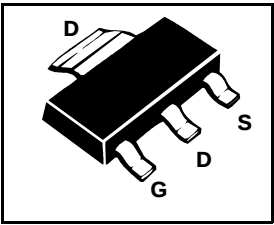
ZVN4210G

ISSUE 2 - NOVEMBER 1995

FEATURES

* Low $R_{DS(on)} = 1.5\Omega$

PARTMARKING DETAIL - ZVN4210



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	V_{DS}	100	V
Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^{\circ}C$	I_D	0.8	A
Pulsed Drain Current	I_{DM}	6	A
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	2	W
Operating and Storage Temperature Range	T_j, T_{stg}	-55 to +150	$^{\circ}C$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	100		V	$I_D=1mA, V_{GS}=0V$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	0.8	2.4	V	$I_D=1mA, V_{DS}=V_{GS}$
Gate-Body Leakage	I_{GSS}		100	nA	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}		10 100	μA μA	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0$ $V_{DS}=80V, V_{GS}=0V, T=125^{\circ}C(2)$
On-State Drain Current(1)	$I_{D(on)}$	2.5		A	$V_{DS}=25V, V_{GS}=10V$
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$		1.5 1.8	Ω Ω	$V_{GS}=10V, I_D=1.5A$ $V_{GS}=5V, I_D=500mA$
Forward Transconductance(1)(2)	g_{fs}	250		mS	$V_{DS}=25V, I_D=1.5A$
Input Capacitance (2)	C_{iss}		100	pF	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1MHz$
Common Source Output Capacitance (2)	C_{oss}		40	pF	
Reverse Transfer Capacitance (2)	C_{rss}		12	pF	
Turn-On Delay Time (2)(3)	$t_{d(on)}$		4	ns	$V_{DD}=25V, I_D=1.5A$
Rise Time (2)(3)	t_r		8	ns	
Turn-Off Delay Time (2)(3)	$t_{d(off)}$		20	ns	
Fall Time (2)(3)	t_f		30	ns	

(1) Measured under pulsed conditions. Width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$ (2) Sample test.

(3) Switching times measured with 50 Ω source impedance and <5ns rise time on a pulse generator
Spice parameter data is available upon request for this device

ZVN4210G

DRAIN-SOURCE DIODE CHARACTERISTICS

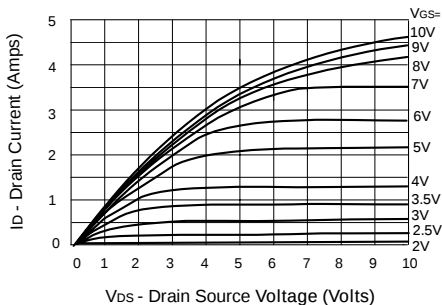
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Diode Forward Voltage (1)	V_{SD}	-	0.79	-	V	$I_S=0.32A$, $V_{GS}=0V$
		-	0.89	-	V	$I_S=1.0A$, $V_{GS}=0V$
Reverse Recovery Time (to $I_R=10\%$)	T_{RR}	-	135		ns	$I_F=0.45A$, $V_{GS}=0V$, $I_R=100mA$, $V_R=10V$

(1) Measured under pulsed conditions. Width=300 μ s. Duty cycle $\leq 2\%$ (2) Sample test.

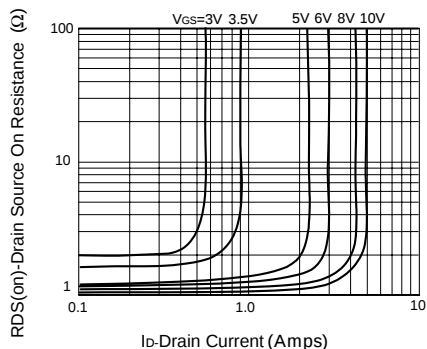
(3) Switching times measured with 50 Ω source impedance and <5ns rise time on a pulse generator
Spice parameter data is available upon request for this device

ZVN4210G

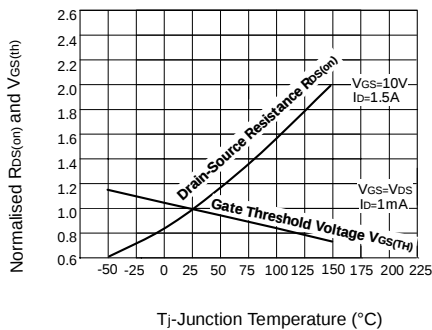
TYPICAL CHARACTERISTICS



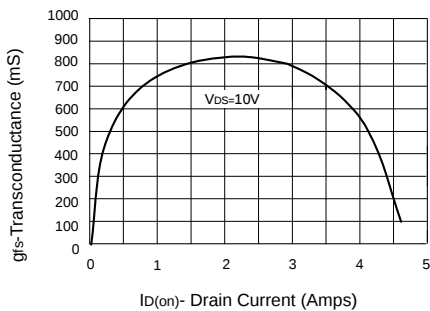
Saturation Characteristics



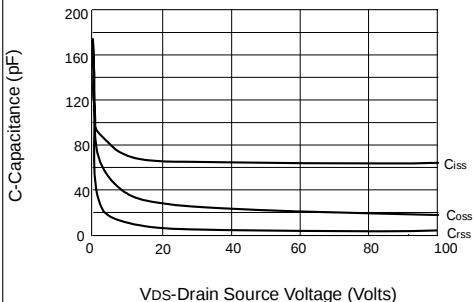
On-resistance v drain current



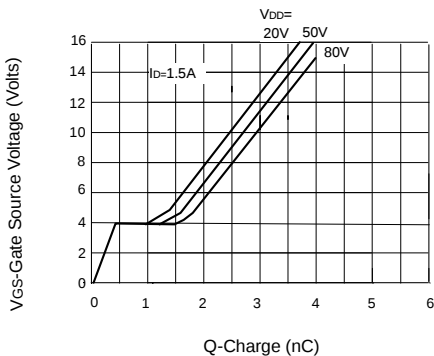
Normalised RDS(on) and VGS(th) v Temperature



Transconductance v drain current



Capacitance v drain-source voltage



Gate charge v gate-source voltage



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.